

# АНОМАЛИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕНОСА В ПЛАЗМЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПОЛЕ МОЩНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

*В.П.Силин*

*Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН  
117924 Москва, Россия*

Поступила в редакцию 29 мая 1996 г.

Показано, что в поле мощного излучения электронная сила трения, обусловленная столкновениями электронов с ионами, становится силой ускорения электронов благодаря поглощению электронами энергии излучения. Указано на увеличение теплопроводности.

**PACS:** 52.25.Dg

Интерес к кинетике плазмы в поле мощного излучения возрос в связи с разработкой короткоимпульсных лазеров высокой мощности. Последнее привело к тому, что условия, в которых скорость  $v_E = eE/m\omega$  осцилляций электрона в поле излучения с частотой  $\omega$  оказывается больше тепловой, реализуются не только в СВЧ диапазоне, но и в лазерном диапазоне. Первоначально такие условия привлекли внимание в связи с проблемой столкновительного поглощения мощного излучения [1] (см. также [2] и цитируемую там литературу). В работе [3] рассмотрено влияние поля излучения на релаксацию температуры. В настоящем сообщении рассмотрена релаксация импульса электронов в полностью ионизированной плазме. Показано, что в случае достаточно мощного излучения столкновения электронов с ионами ведут не к замедлению движения электронов, а к их ускорению, что обусловлено поглощением электронами энергии излучения.

Для того чтобы выявить аномальные свойства плазмы, воспользуемся простейшей моделью, когда излучение имеет следующую эллиптическую поляризацию:  $E = (E_x, E_y, E_z) = E(-\cos \alpha \sin \omega t, \sin \alpha \cos \omega t, 0)$ . В поле такого излучения электрон осциллирует со скоростью  $u_E(t) = v_E(\cos \alpha \cos \omega t, \sin \alpha \sin \omega t, 0)$ . При этом будем считать, что амплитуда скорости осцилляций электрона  $v_E$  значительно превышает его тепловую скорость  $v_T = \sqrt{k_B T/m}$ . В свете положений работы [1] вместо обычной функции распределения  $f(v, r, t)$  удобно использовать функцию  $F(u, r, t) = f(v, r, t)$ , где  $u = v - u_E(t)$ . При этом для усредненной по периоду быстрых осцилляций функции  $\langle F \rangle = F_0(u, r, t)$  в случае поля, слабо изменяющегося на расстоянии порядка амплитуды осцилляции положения электрона  $a_E = v_E/\omega$ , имеем следующее кинетическое уравнение:

$$\frac{\partial F_0}{\partial t} + u \frac{\partial F_0}{\partial r} + \left( \frac{e}{m} E_0 - \frac{e^2}{4m^2\omega^2} \frac{\partial |E|^2}{\partial r} \right) \frac{\partial F_0}{\partial u} = \\ = \langle J_{ei}[u + u_E(t), F_0(u)] \rangle + J_{ee}[F_0, F_0], \quad (1)$$

где  $E_0$  – квазистатическое (медленно меняющееся за период  $2\pi/\omega$ ) электрическое поле. Электрон-ионный  $J_{ei}$  и электрон-электронный  $J_{ee}$  интегралы столкновений можно использовать в форме Ландау. При этом на относительное движение сталкивающихся друг с другом электронов их осцилляции не

влияют. На электрон-ионные столкновения осцилляции влияют. Пренебрегая малыми порядка отношения масс электрона и иона, для описания релаксации импульса электронов используем

$$\langle J_{ei}[\mathbf{u} + \mathbf{u}_E(t), F_0(\mathbf{u})] \rangle = A \frac{\partial}{\partial u_k} \langle D_{kj}(\mathbf{u} + \mathbf{u}_E(t)) \rangle \frac{\partial F_0}{\partial u_j}. \quad (2)$$

Здесь  $A = 2\pi e^2 e_i^2 n_i \Lambda_{ei} / m^2$ , где  $n_i$  – плотность числа ионов, а  $\Lambda_{ei}$  – кулоновский логарифм, вид которого в поле мощного излучения обсужден в [4]. Наконец,

$$\langle D_{kj}(\mathbf{u} + \mathbf{u}_E(t)) \rangle = \langle \{(u + u_E)^2 \delta_{kj} - (u + u_E)_k (u + u_E)_j\} |u + u_E|^{-3} \rangle. \quad (3)$$

Простой путь получения ответа на интересующий нас вопрос об электрон-ионной релаксации импульса может быть получен в пятимоментном приближении метода моментов Греда, когда используется локальная максвелловская функция распределения электронов со сдвигом на упорядоченную скорость  $u^e$  движения электронов. Это дает уравнение движения (ср. [5]):

$$mn \left( \frac{\partial \mathbf{u}^e}{\partial t} + \left( \mathbf{u}^e \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right) \mathbf{u}^e \right) + \frac{\partial p}{\partial \mathbf{r}} - n \left( e \mathbf{E}_0 - \frac{e^2}{4m\omega^2} \frac{\partial |\mathbf{E}|^2}{\partial \mathbf{r}} \right) = \mathbf{R}^{ei}. \quad (4)$$

Здесь  $n$  – плотность числа электронов,  $p = n k_B T$  – их давление, а  $\mathbf{R}^{ei}$  в методе Греда носит название силы трения:

$$\mathbf{R}^{ei} = m \int d\mathbf{u} (\mathbf{u} - \mathbf{u}^e) \langle J_{ei}[\mathbf{u} + \mathbf{u}_E(t), F_0(\mathbf{u})] \rangle. \quad (5)$$

Линеаризуя это выражение по скорости  $u^e$  упорядоченного движения электронов, получаем:

$$(\mathbf{R}^{ei})_k = -mn \nu_{kj} u_j^e. \quad (6)$$

В рассматриваемом нами случае эллиптической поляризации тензор  $\nu_{kj}$  эффективной частоты столкновений оказывается диагональным. Особенно просто проиллюстрировать аномальное свойство релаксации импульса электронов в случае поляризации излучения, близкой к плоской, когда  $\sin \alpha \ll 1$ . Однако при этом будем считать выполненным неравенство

$$eE \sin \alpha \gg m\omega v_T. \quad (7)$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned} \nu_{xx} &= -\tilde{\nu}(E) \left\{ \ln \frac{4}{\sin \alpha} - 1 \right\}, \\ \nu_{yy} &= -\tilde{\nu}(E) \left\{ \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{2} \ln \frac{4}{\sin \alpha} + \frac{5}{4} \right\}, \\ \nu_{zz} &= \tilde{\nu}(E) \left\{ \frac{1}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{2} \ln \frac{4}{\sin \alpha} + \frac{1}{4} \right\}, \end{aligned} \quad (8)$$

где

$$\tilde{\nu}(E) = \frac{8e^2 e_i^2 n_i \Lambda_{ei}}{m^2 v_E^3}. \quad (9)$$

Отметим, что в используемом приближении сильного поля след тензора  $\nu_{kj}$  равен нулю. В соответствии с этим в рассматриваемом нами случае воздействия

на плазму мощного излучения  $xx$ - и  $yy$ -компоненты тензора эффективной частоты столкновений оказываются отрицательными. Это означает, что в поле мощного излучения сила трения электронов превращается в силу ускорения. Действительно, пренебрежем в уравнении (4) пространственной неоднородностью. Тогда, например, для  $y$ -компоненты скорости имеем:

$$\frac{du_y^e}{dt} - \frac{e}{m} E_{0y} = \tilde{\nu}(E) \frac{1}{\sin^2 \alpha} u_y^e. \quad (10)$$

В случае  $E_{0y}$  и  $\tilde{\nu}(E)$ , не зависящих от времени, решение этого уравнения имеет вид

$$u_y^e(t) = u_y^e(0) \exp\left(\frac{t}{t_{\text{уск}}}\right) + \frac{eE_{0y}}{m} t_{\text{уск}} \left\{ \exp\left(\frac{t}{t_{\text{уск}}}\right) - 1 \right\}, \quad (11)$$

где  $t_{\text{уск}} = \sin^2 \alpha \tilde{\nu}^{-1}(E)$  – время ускорения. Первое слагаемое в правой части (11) отвечает спонтанной генерации ускоренных электронов, а второе – индуцируемой статическим полем. В случае  $E_{0y} \sim \exp(-i\omega_1 t)$  уравнение (10) позволяет определить комплексную проводимость

$$j_y = \sigma_{yy} E_{0y}, \quad \sigma_{yy} = \frac{e^2 n}{m} \frac{i\omega_1 - t_{\text{уск}}^{-1}}{\omega_1^2 + t_{\text{уск}}^{-2}}. \quad (12)$$

В пределе  $\omega_1 = 0$  формула (12) отвечает отрицательной статической проводимости. При  $\omega_1 \neq 0$  действительная часть комплексной проводимости (12) отрицательна, что отвечает возможности усиления и генерации излучения. В пределе  $\omega_1 > \omega_{Le} = \sqrt{4\pi e^2 n/m}$  последнее явление было предсказано в работах [6, 7], а соответствующая эффективная частота столкновений, определяющая высокочастотную проводимость, была найдена в работе [8] для излучения плоской и круговой поляризации.

В заключение заметим, что благодаря тому факту, что в уравнении (1) электрическое поле не влияет на электрон-электронные столкновения, а электрон-ионные столкновения при  $v_E \gg Zv_T$  сильно подавлены, теплопроводность плазмы оказывается отвечающей модельному случаю электронного газа, когда для коэффициента теплопроводности в приближении двух полиномов метода Гильберта-Чепмена-Энскога имеем

$$\chi = \frac{375}{128} \frac{\kappa_B m^2 v_T^5}{\sqrt{\pi e^4 \Lambda_{ee}}}. \quad (15)$$

Для плазмы с ионами высокой кратности ионизации  $Z = |e_i/e| \gg 1$  этот коэффициент теплопроводности примерно в  $Z$  раз превышает обычный [5, 9].

Если причина увеличения теплопроводности плазмы в поле мощного излучения связана с подавлением электрон-ионных столкновений из-за возрастания относительной скорости движения сталкивающихся частиц, то причина аномалии, превращающей силу электронного трения в силу ускорения, связана с поглощением электронами мощного греющего излучения. При этом именно поглощение высокочастотного излучения с частотой, большей частоты электронных столкновений, является причиной обсужденных аномальных свойств плазмы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 96-02-17002-а, а также в рамках проекта ИНТАС – 94-0870.

- 
1. В.П.Силин, ЖЭТФ **47**, 2254 (1964).
  2. C.D.Decker, W.B.Mori, J.M.Dawson, and T.Katsouleas, Phys. Plasmas **1**, 4043 (1994).
  3. A.Ya.Polishchuk and J.Meyer-Ter-Vehn, Phys. Rev. **E49**, 663 (1994).
  4. В.П.Силин, С.А.Урюпин, ЖЭТФ **81**, 910 (1981).
  5. В.П.Силин, *Введение в кинетическую теорию газов*, М.: Наука, 1971.
  6. M.V.Fedorov and R.V.Karapetyan, J. Phys. A Math. Gen. **9**, L 103 (1976).
  7. Р.В.Карапетян, М.В.Федоров, *Квантовая электроника*, **4**, 2203 (1977).
  8. B.N.Chichkov and S.A.Uryupin, Phys. Rev. **E 48**, 4659 (1993).
  9. С.И.Брагинский, *Вопросы теории плазмы*, вып. 1, под ред. М.А.Леоновича, М.: Госатомиздат, 1963, с.183.